

267069.

19 ABR



PATENTE

DE

INTRODUCCION

a favor de Don Angel HERNÁNDEZ LÓPEZ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Calle Farigola, 20, por "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN BARNIZ POLIAMÍDICO SEMICONDUCTOR".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un procedimiento para la preparación de un barniz poliamídico semi-conductor, especialmente apto para el recubrimiento de conductores eléctricos, mediante cuyo procedimiento se consiguen varias e importantes ventajas prácticas con relación a las ejecuciones usuales.

El objeto de la demanda recae en un barniz poliamídico con carga de grafito, destinado a proporcionar una capa protectora de naturaleza semiconductora.

26 7 06 9



Esencialmente, el referido procedimiento consiste en preparar una solución al 10% de poliamida en isopropanol y agua disolviendo la poliamida en una mezcla en ebullición de agua (una parte) e isopropanol (4 partes), adicionando a la solución caliente una cantidad igual de una dispersión al 20% de grafito coloidal en isopropanol y diluyendo la mezcla, hasta conseguir la deseada consistencia, agregando una tercera cantidad igual de una mezcla de agua e isopropanol, calculándose en peso todos los componentes empleados.

Para la mejor comprensión del objeto de la demanda se describe a continuación un caso práctico de preparación del citado barniz poliamídico semiconductor.

15. Se disuelven 100 partes de poliamida en una mezcla en ebullición de 180 partes de agua y 720 partes de isopropanol.

A la referida solución, aún caliente, se agregan 1000 partes de una dispersión al 20% de grafito coloidal en isopropanol, agitando todo ello para que no se formen grumos.

La mezcla resultante se diluye agregándole 1000 partes de una mezcla de 640 partes de isopropanol y 360 partes de agua.

25. El barniz obtenido contiene un 10% de cuerpos sólidos, dividido en 6,67% de grafito y 3,33% de poliamida. Por tanto, dicho barniz comprende un 72% de isopropanol y un 18% de agua.



26 7 06 919 ABR.

5. La fórmula descrita puede presentar una tendencia a la gelificación, por lo que antes del empleo debe calentarse a unos  $52^{\circ}\text{C}$ ., agitando para eliminar los grumos. El barniz puede diluirse después con isopropanol para conseguir la necesaria consistencia para la aplicación sobre el correspondiente conductor eléctrico.

10. El recubrimiento de los conductores puede efectuarse en una torreta de barnizar, siendo preferible que aquéllos se calienten en el momento de pasar por dicha torreta antes de la aplicación de la primera capa de barniz; Pueden aplicarse una o varias de tales capas, secándose cada una de ellas antes de aplicar la siguiente.

15. Serán independientes de la invención las proporciones de las materias empleadas, características de la instalación de barnizar y demás detalles de orden secundario que no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

20. Se reivindica como objeto de la presente patente de introducción:

1. Procedimiento para la preparación de un barniz poliamídico semiconductor, que consiste esencialmente en disolver una poliamida en una mezcla en ebulli-

26 7 0619 ASB



ción formada por agua e isopropanol, adicionando a la solución caliente una dispersión de grafito coloidal en isopropanol y diluyendo la mezcla, hasta conseguir la deseada consistencia, agregando una tercera cantidad de una mezcla de agua e isopropanol.

5. 2. Procedimiento para la preparación de un barniz poliamídico semiconductor, según la reivindicación 1, caracterizado porque se disuelve 10% de la poliamida en una parte de agua y 4 partes de isopropanol y la dispersión empleada contiene 20% de grafito coloidal calculados en peso todos los componentes empleados.

10. 3. Procedimiento para la preparación de un barniz poliamídico semiconductor.

15. La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 19 de abril de 1961.

Angel HERNÁNDEZ LÓPEZ

p. a.